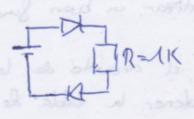
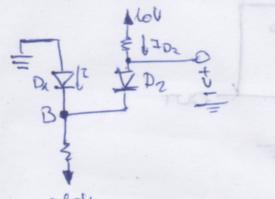
Examen Mays 2015 - FUTFI

- D'una oblem de silicio extrinseco de tipo N presenta una revistividad de 0'045.2 con. Determinar la concentración de portadores (0'5p)
- 2) Tenemos una muestra de Silició en la que tras varios processos de implantación iónica se construye una estructura heterográfica NPN. c Cómo debe diseñarse para que Suncione como un transistor y no cómo los diodos enfrentados? Razonar la respuesta. (015p)
- 3. Dado el circuito siguierte, apponiendo una tensión de despogue Vy = 017 V para los 2 diodos, completa la Habla: (015p)

Vi (V)	VR(V)	Is (my)
-3	(9/9	A) (0)~
7-1	1	0 000
0	7	A Bala
3	· s oh	الم وتدور



Para el circuito de la figura siguiente, calcular I y V Asumir que los diodos son ideales y que ambas resistencias son de MCA. (015 p)



(5) Dala la Sución F = (A1+ A2 + A3) (B1+B2). C

a) Implementar en légica CMOS complementario de modo que si assumimos va recológia dende Rp = 3RN para transistores PMOS y NMOS del mismo temario, los retardos de

propagación esan menoras o iguales a las de un inversor de tamaro mínimo implementado can la misma tecnología (OSP)

b) Hacer u diseño en lógica poeudo-NHOS en $V_0 \le 1V$ y tente $\le 34^{\circ}5ns$. Considerar una carga de $C_1 = 1pF$, mucho mayor que la capacidad intrinsear de la prenta lógica. $V_{DD} = 5V$, $R_0 = R_0 = 2 \cdot lo^4 \cdot \left(\frac{L}{W}\right)$, $L_{mi} = W_{min} = 1 \mu m$ (1 pto)

e) Diseñar la Surción F=(A1+A2+A3). (B1+B2). C mediante lógica denámica de 2 niveles y on uso de inversores (0'E

6 Dibujar una cella SRAM. Describir su fucionamiento en molo lectura y en modo escritura. Explicar las restricciones que aparecen en el dimensionale de los transistores para garantizar un boen fucionamiento. (Apto)

Dado el circuito de la Sigura siguiete: (1 pto)
a) Obtener la table de la verdad de la Sución que implementa. ¿De que tipo de circuito se trata?

b) si se eliminase el transistar Mp, cel-circuito certinuaria duncionardo correctamente? ¿ cevé papel desempera dicho transistor?

(3) Dele la grade F = (1, 1 h, 1 h) (32+ B))

